

Dk 3.08 Df 0.0012 @14GHz

Tg (DMA) 220°C

T288 (銅付) >120分

用途
ネットワーク/ワイヤレス通信
 ルータ、スイッチ、光伝送装置、サーバ、AIサーバ、基地局、半導体試験装置、プローブカードなど

MEGTRON8S MEGTRON8

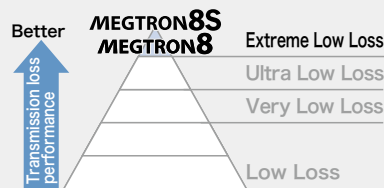
Laminate
R-5795S(U)/(N)
 Prepreg
R-5690S(U)/(N)

Laminate
R-5795(U)/(N)
 Prepreg
R-5690(U)/(N)

(U): Ultra-low Df glass cloth type
 (N): Low Dk glass cloth type

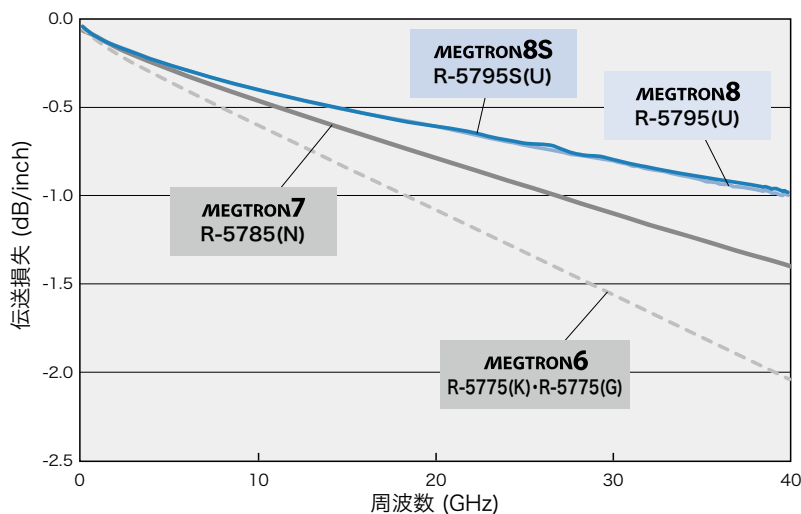
超低伝送損失・高耐熱多層基板材料

次世代高速通信技術800GbE対応。
 MEGTRON8 R-5795(U)と
 MEGTRON7 R-5785(N)比較で伝送損失を約30%改善(28GHz時)し、高速通信ネットワーク機器の性能向上に貢献。



伝送損失比較

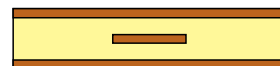
MEGTRON8 R-5795(U)、MEGTRON7 R-5785(N)と比較し、伝送損失を約30%改善(*)



(※) 28GHz時の伝送損失改善効果

$$\frac{\text{伝送損失の差 (MEGTRON7 - MEGTRON8)}}{\text{伝送損失 (MEGTRON7)}} \times 100 \approx 30(\%)$$

評価サンプル (断面図)



PCB構成	3層PCB ストリップライン
銅箔厚み	18 μm(内層)
コア材	0.13mm
プリプレグ	0.15mm
特性インピーダンス	50Ω
内層表面処理	表面処理なし
測定方法	2ポート Sパラメータ
測定周波数	0.2 - 40GHz
校正方法	マルチラインTRL法

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

一般特性

項目	試験方法	条件	単位	MEGTRON8S R-5795S(U)	MEGTRON8S R-5795S(N)	MEGTRON8 R-5795(U)	MEGTRON8 R-5795(N)	
				Ultra-low Df glass cloth	Low Dk glass cloth	Ultra-low Df glass cloth	Low Dk glass cloth	
ガラス転移温度(Tg)	DMA	A	°C	220	220	220	220	
熱膨張係数 (厚さ方向)	α1	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	35	35	50	50
					α2	240	240	270
T288(銅付)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分	>120	>120	>120	>120	
比誘電率(Dk)	14GHz	平衡型円板共振器法	C-24/23/50	-	3.19	3.22	3.08	3.13
誘電正接(Df)					0.0012	0.0015	0.0012	0.0016
銅箔引き剥がし強さ	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.7 [H-VLP3]	0.7 [H-VLP3]	0.7 [H-VLP3]	0.7 [H-VLP3]

試験片の厚さは0.75mmです。

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。